2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年１月31日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　樋口　秀樹　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年12月12日から平成24年１月31日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Integrated Laboratory Information System with measures against disaster 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　To perform both of routine and emergency testing in Chemistry, Immunology, Blood glucose, Hematology, Coagulation, Urinalysis, Microbiology and Genetics.
B　To prepare the necessary equipments for blood collection and blood transfusion.
C　To control analyzers for clinical laboratory equipment and Laboratory automation system. Also, required quality control for the results.
D　To be connectable to existing Hospital information system and Blood transfusion system.
E　To prepare the necessary measures against vibration, blackout and disrupted water supply／discharge by the disasters.
F　To prepare the necessary security measures and measures in system failure to protect the patient information.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 31, January, 2012
⑹　Contact point for the notice : Higuchi Hideki, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 23 年 12 月 12 日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第４号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　12
⑵　導入計画物品及び数量
シリコン深溝エッチング装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度５月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　搬送モジュールとプロセスモジュールを有し、そのプロセスモジュールを６機以上搭載することが可能なクラスター型であること。
B　200㎜ウェハ、300㎜ウェハの処理が可能なDeep ＲＩＥ装置であること。
C　各ウェハの搬送モジュールの改装は必要なく、またプロセスモジュールの改装も簡易に行えること。
D　シリコン、SiN膜、酸化膜の異方性エッチングができること。
E　バックグラウンド圧力が、１×10－５Torr以下まで到達すること。
F　ガスラインは最大10系統で、Ar、Ｏ２、Ｃ４Ｆ８、ＳＦ６、Ｎ２ガスラインを有すること。
G　直径１μmから３μmまでのアスペクト比30以内のＴＳＶに対応するため、Non Bosch方法によるシリコンエッチングとBosch方法によるシリコンエッチング機構を有する事。φ１μm以下、深さ40μm以上Si深堀が出来ること。
H　プラズマチャンバー中心軸上とプラズマ周辺付近のプラズマ密度が独立に制御できる機構を有すること。
I　シリコンの露出面積が小さいもの（５％以下）からシリコン全面（100％）をエッチバックするようなパターンまで±５％以内で均一にエッチングすることが可能であること。
J　ソース内側と外側にそれぞれＩＣＰ（誘導結合型高周波プラズマ）発生用コイルを備えること。また、このコイルにそれぞれＲＦ電源を備え、印加するＲＦ電力を個別に制御できること。
K　プラズマチャンバー中心上とプラズマ周辺付近のガス導入流量が独立に制御できる機構になっていること。
L　エッチングステップ、パッシベーションステップを各々複数個分けることができ、各プロセスパラメータ（プロセスガス流量、プロセス圧力、ＲＦ電源出力）を独自に設定できること。
M　試料台でのウェハ保持は静電チャック方式であること。また、ウェハ冷却用裏面Heの圧力を中央部、外周部で独立に制御できること。
N　ウェハ周辺部がフォトレジストで被覆されていないウェハに対してもその周辺露出部のシリコンをエッチングしない機構を有していること。
O　エッチング時にシリコンとシリコン酸化膜界面にてノッチが入らないこと。
P　試料台用高周波バイアス電源は、高速パルス変調機能を有すること。
Q　ＯＥＳ（プラズマ発光分光）式エンドポイントディテクタを装備し、エッチング終点検知が可能なこと。
R　ウエハ外周部で局所的に見られる形状の傾きを改善するためのバイアスを印加できる機能がついていること。
S　エッチング材に対し、最適なプラズマ密度を得るために、プラズマソース用アンテナ位置を可動できること。
T　複合分子ポンプを装備すること。複合分子ポンプの特質は、Deep ＲＩＥ特有の大量の堆積物に対する付着抑制対策を施され、かつ、化学ガスに対する耐食用表面処理を施した磁気浮上型ターボポンプであること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年１月20日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　樋口　秀樹　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年12月12日から平成24年１月20日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年12月19日09時30分
⑵　開催場所　東北大学未来科学技術共同研究センター１階小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 12
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Deep Silicon reactive ion etching system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system must have a transfer module and a process module and be cluster types available to dock more than 6 units.
B　The system is Deep RIE which has capability to process 200-㎜ and 300-㎜ wafers.
C　When the wafer size will be changed, there should not be necessary to change anything in transfer modules, and it should be fairly easy to change the necessary parts in process modules.